

Г АВЛ.431268.013СБ

Перв. примен.
Г АВЛ.431268.013

Справ. №

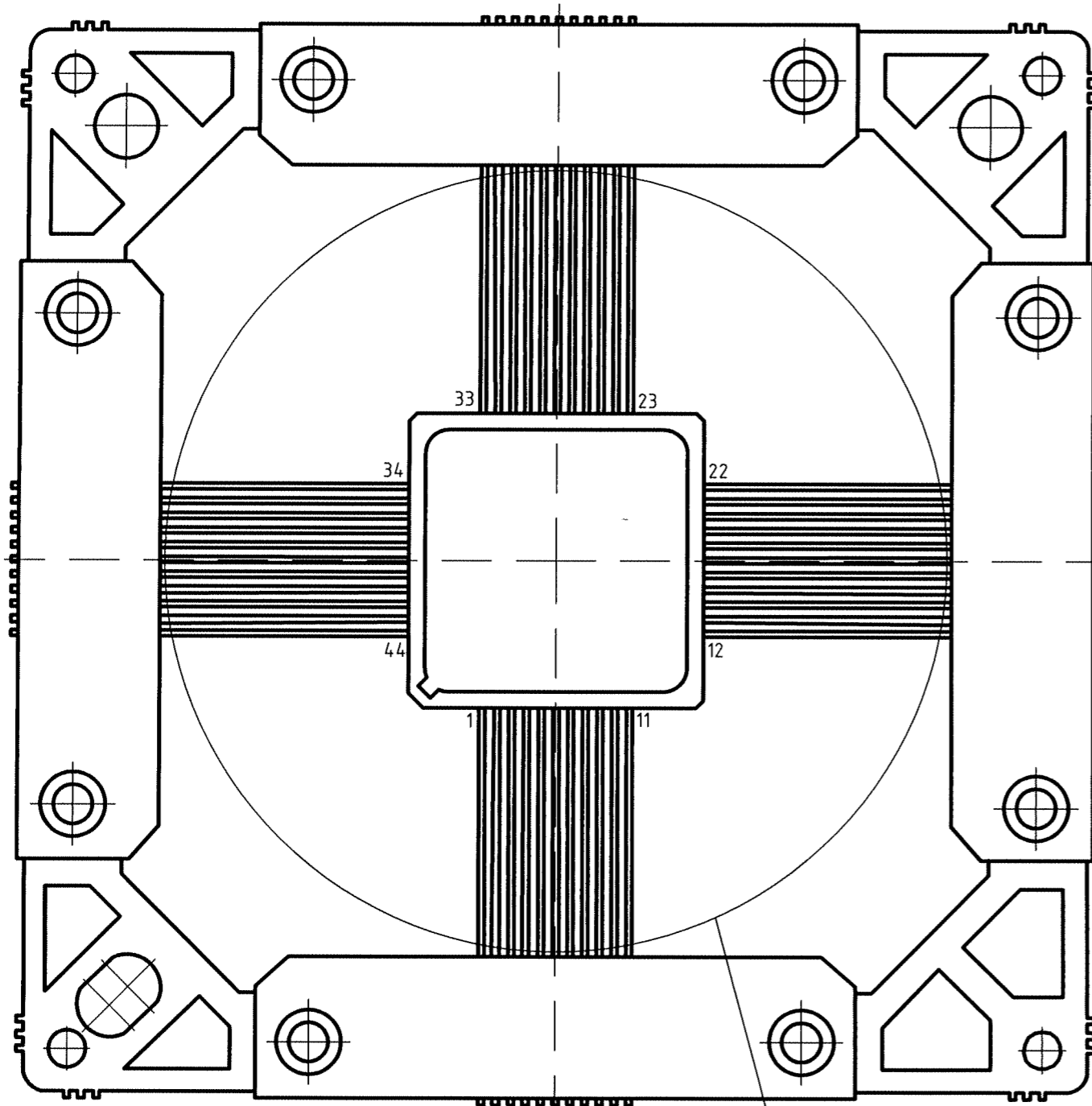
Подп. и дата

№ дцбл

Взам. инв. № Инв. № дцбл

Подп. и дата

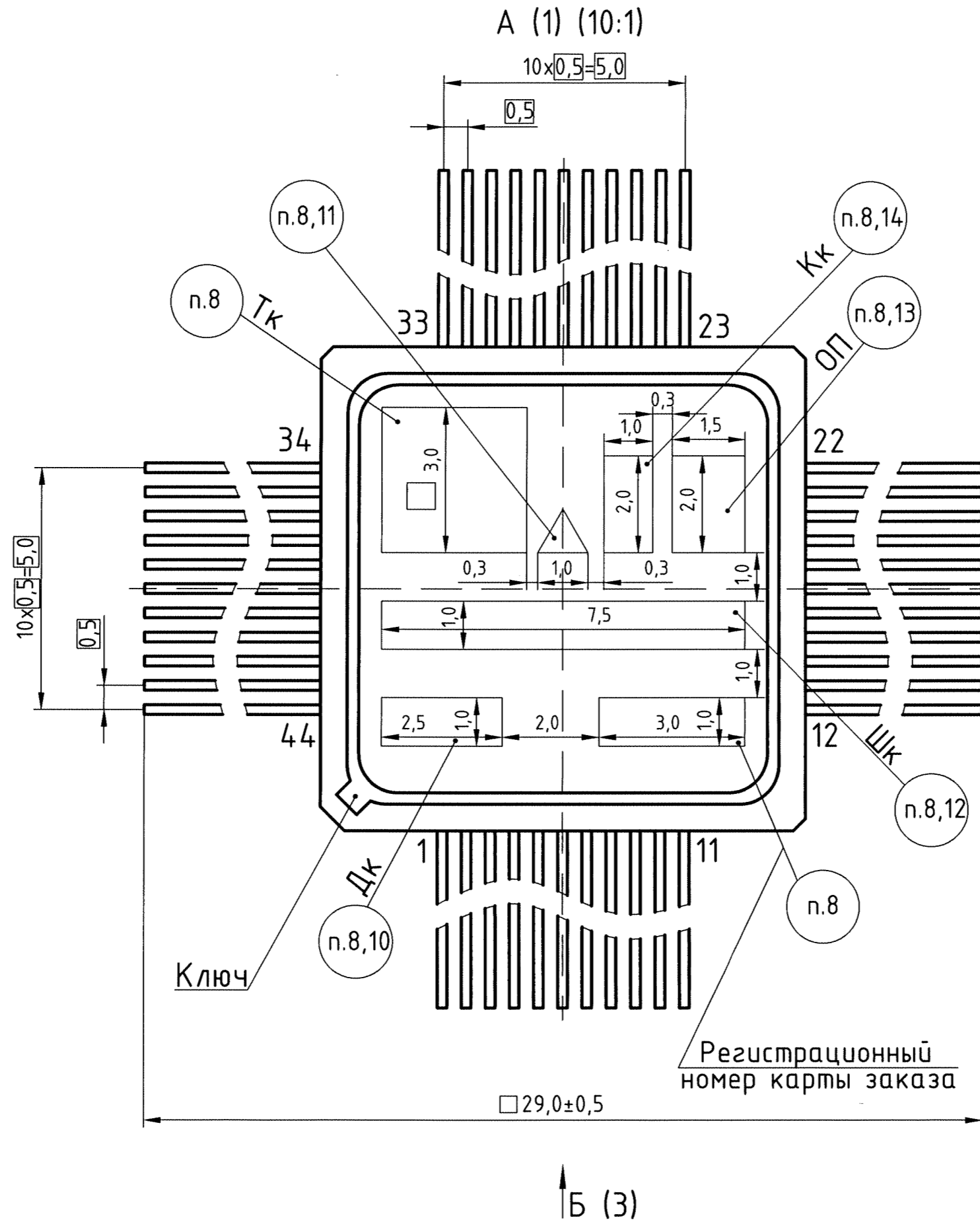
Инв. № подл.
1540



1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина E- максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3}$ Па*см³/с.
7. Внешний вид микросхем 5529ТР024 должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,0 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно основному виду. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду Г.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать "5529ТР024".
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
14. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.
16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.013ЭТ.

Г АВЛ.431268.013СБ

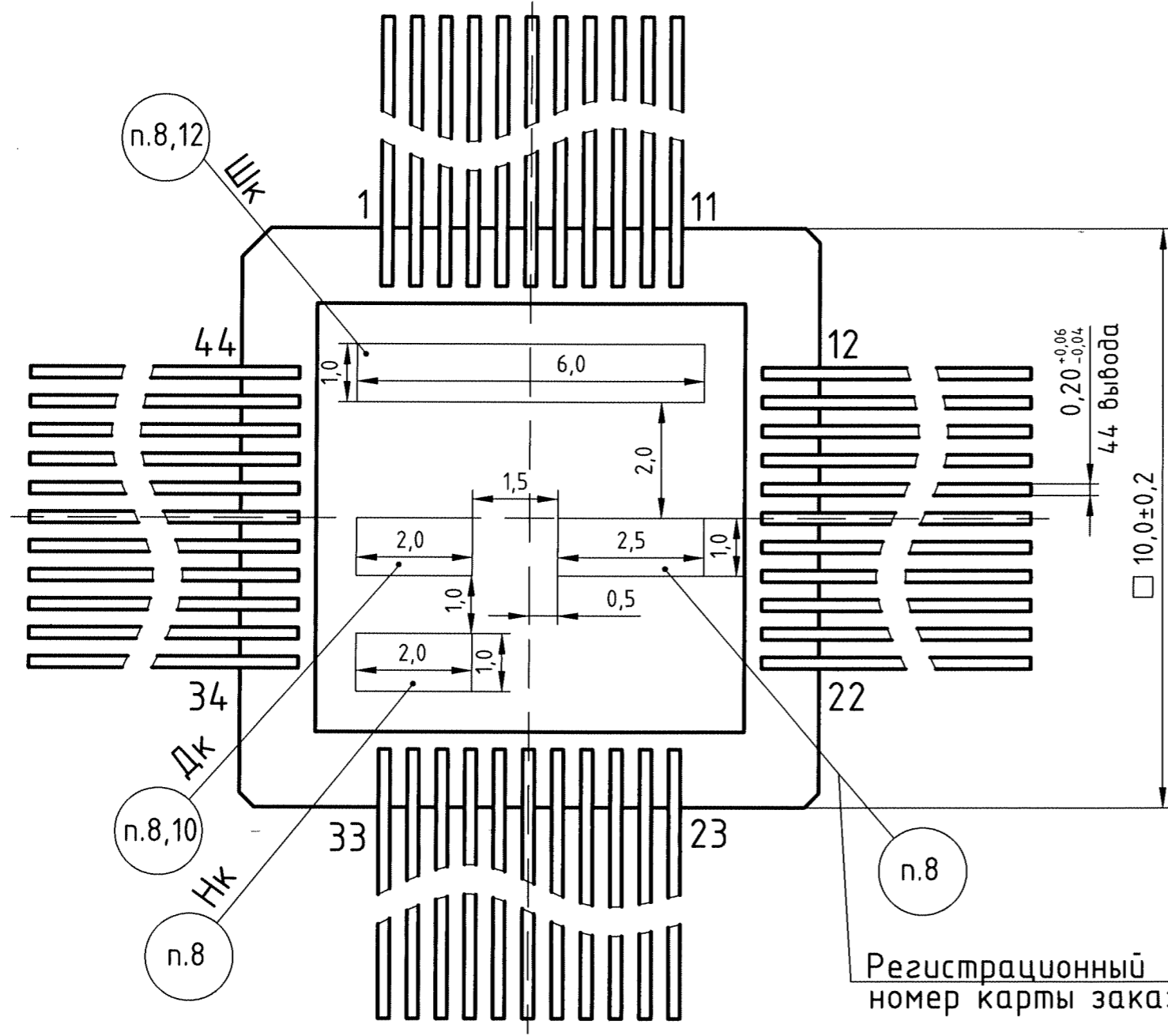
				Г АВЛ.431268.013СБ				
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>СВ</i>	09.19	Микросхема интегральная 5529ТР024 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата		A	max 3,5 г	5:1
Разраб.	Астахова	<i>СВ</i>	13.11.19			Лист 1	Листов 3	
Пров.	Тукашкин	<i>БС</i>	13.11.19					
512 ВП	Чириченко	<i>СВ</i>	5.12.19					
Н.контр.	Казаков	<i>СВ</i>	13.11.19					
Утв.	Денисов	<i>СВ</i>	13.11.19					



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл	Подп. и дата
1540	16.01.19			

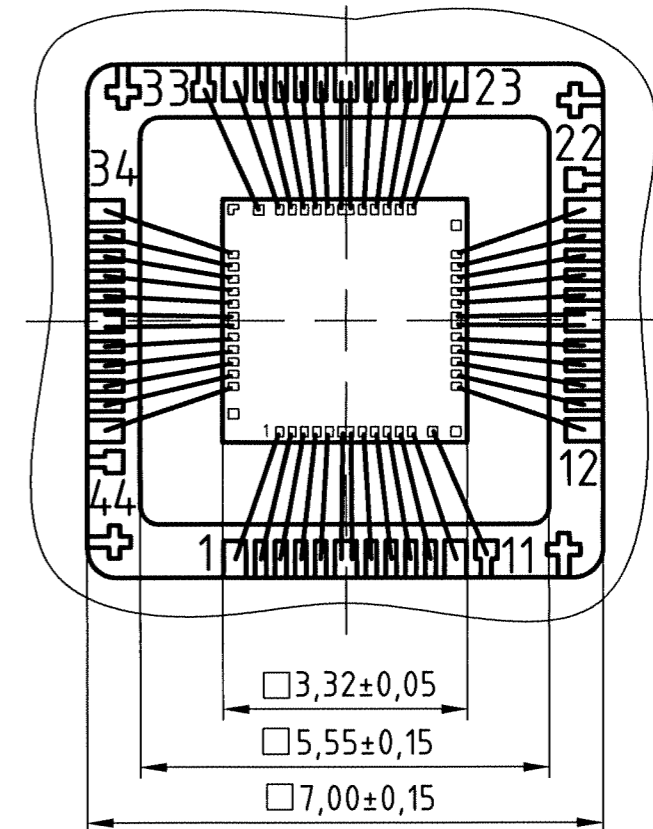
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	16.01.19
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата

Г (10:1)

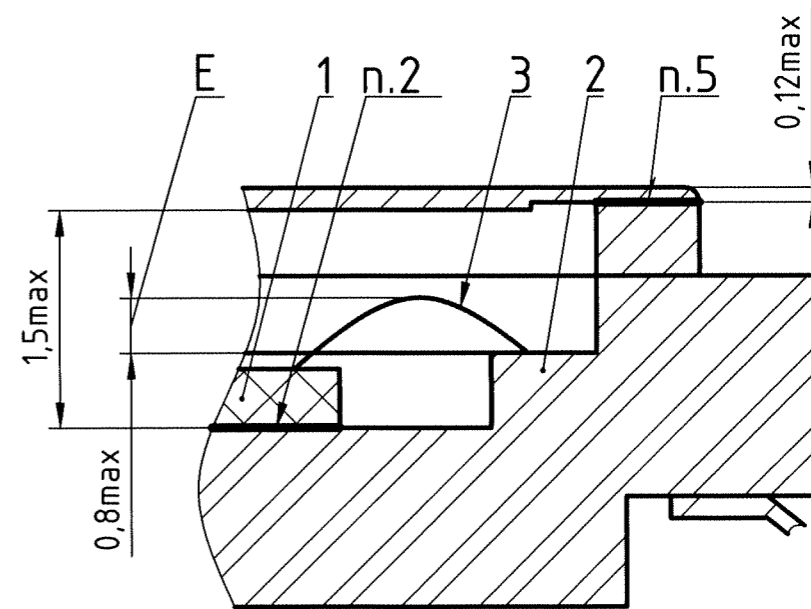


В (10:1)

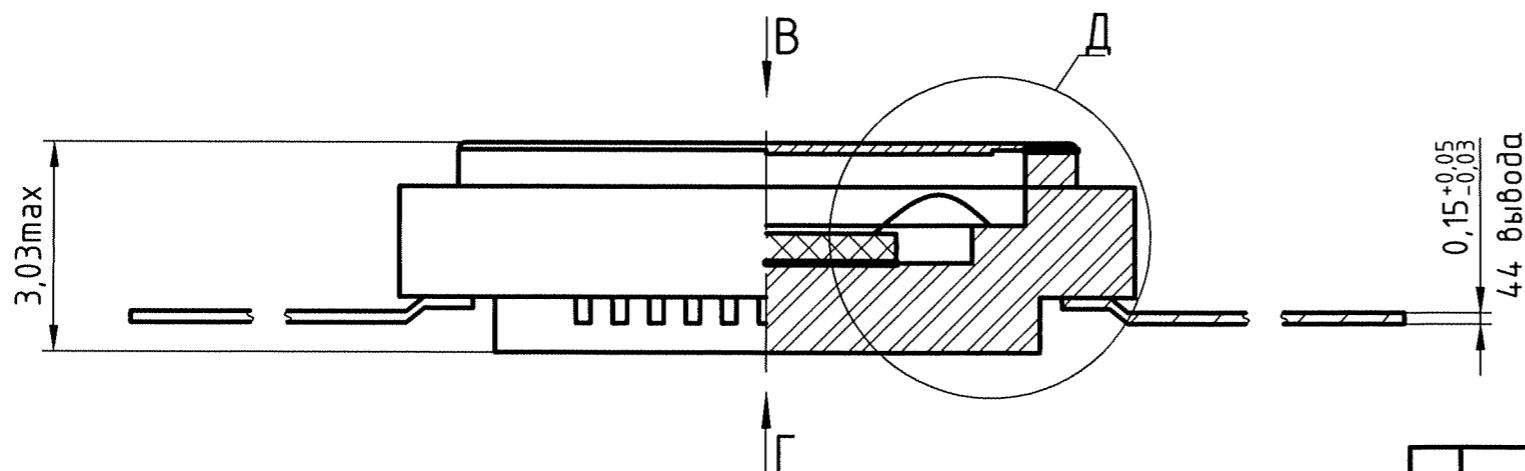
Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны



Д (20:1)



Б (2) (10:1)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1540	Рез 16.01.20			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	РБВ/Б
Изм/Лист	Докум.	Пбдп.	Дата